


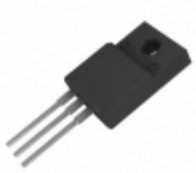




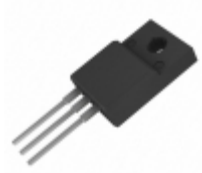

	<h2 style="color: red;">FQAF19N60</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQAF19N60</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11.2A TO-3PF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQAF19N60.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 8057 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF19N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11.2A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8057 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11.2A (Tc) 120W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF19N60 ist neu im Original, Suche FQAF19N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF19N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF19N60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQAF27N25 FSC FQAF27N25 FSC</p>	 <p>FQAF19N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF</p>	 <p>FQAF19N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF</p>	 <p>FQAF19N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11.2A TO-3PF</p>
 <p>FQAF22P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF</p>	 <p>FQAF17P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 12.4A TO-3PF</p>	 <p>FQAF19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A TO-3PF</p>	 <p>FQAF19N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A TO-3PF</p>

heiße Teile

Mehr

FQAF9N90C_F109	FQA9N90_F109	FQAF10N80	D FQAF10N80	FQAF11N40
FQAF11N40	FQAF11N90	D FQAF11N90	FQAF11N90C	FQAF11N90C
FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50	FQAF13N80	FQAF13N80
D FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25	FQAF16N25	FQAF16N25C
FQAF16N25C	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF17N40	FQAF17N40
FQAF17P10	FQAF17P10	D FQAF19N20L	FQAF19N20L	FQAF19N60
FQAF22P10	D FQAF22P10	FQAF28N15	FQAF28N15	FQAF33N10
FQAF33N10	FQAF34N20L	FQAF34N25	FQAF34N25	FQAF40N25
FQAF40N25	FQAF5N90	FQAF5N90	D FQAF6N70	FQAF6N90
FQAF6N90	FQAF90N08	FQAF90N08	FQAF9P25	FQAF9P25

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited